

高功率微波

二极管失效和烧毁阈值与电磁波参数关系

[余稳¹](#) [蔡新华¹](#) [黄文华²](#) [刘国治²](#)

(1. 常德师范学院电子学研究所, 湖南常德 415000; 2. 西北核技术研究所, 西安69信箱
710024)

摘要: 利用半导体PN结器件一维模拟程序mPND1D, 计算了二极管在不同电磁脉冲电压源条件下的失效和烧毁时器件吸收的能量, 并对结果作了初步分析。

关键词: [电磁脉冲](#) [半导体器件](#) [失效和烧毁](#) [时域有限差分](#)

通信作者:

相关文章([电磁脉冲](#)):

[电磁脉冲模拟器空间场分布的数值模拟](#)
[γ模拟器与EMP模拟器同步运行可行性研究](#)

[动力飞行体电磁脉冲效应数值分析](#)

[有尾焰动力飞行体电磁脉冲效应数值分析](#)

[电磁脉冲对半导体器件的电流模式破坏](#)

[\[PDF全文\]](#)

[\[HTML摘要\]](#)

[发表评论](#)

[查看评论](#)